



巨磁致电阻器件和磁性隧道结构及包括其的电子设备

专利名称: 巨磁致电阻器件和磁性隧道结构及包括其的电子设备
专利类别: 发明
申请号: 2019106196742
第一发明人: 韩秀峰
其它发明人: 房驰;万蔡华
专利授权日期: 2021-05-25

[关闭窗口](#)

